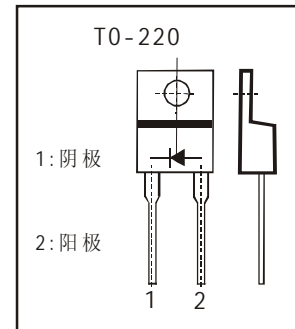


## 肖特基二极管—MBR1045

### 1、概述与特点

- 多层金-半硅势垒结构，多数载流子导电；
- 低功耗，高效率；
- 用于低压高频逆变电路，续流电路和保护电路；
- 带过压（箝）保护环；
- 封装型式：T0-220A。
- 单管芯结构。



### 2、极限值

#### 2.1 极限值：（除其他标注外 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ ）

参数	符号	数值	单位
最大反向重复峰值电压	VRRM	45	V
反向峰值工作电压	VRWM	45	V
最大直流阻断电压	VDC	45	V
$T_{amb} = 105^{\circ}C$ 整个器件最大正向平均整流电流	IF(AV)	10	A
正向峰值浪涌电流(额定负载8.3ms半正弦波—按JEDEC方法)	IFSM	100	A
反向重复峰值浪涌电流 $T_p = 2.0 \mu s, 1KHZ$	IR	0.2	mA
最大结电容 0V, 1MHz	CJ (Max)	300	pF
工作结温	TJ	-65 ~ +150	$^{\circ}C$
储存温度范围	TSTG	-65 ~ +150	$^{\circ}C$

#### 2.2、电性能（除其他标注外 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ ）

参数	符号	数值	单位
最大正向瞬态峰值压降 $TF=10A$ , $T_{amb}=25^{\circ}C$	VF	0.65	V
最大反向瞬态电流 $T_{amb} = 25^{\circ}C$	IR	0.2	mA